特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]



出願人又は代理人 の書類記号 H2245-01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP2004/017146	国際出願日 (日. 月. 年) 18. 11. 2004	優先日 (日.月.年) 26.12.2003					
国際特許分類(IPC)Int.Cl. G09F9/30 (2006.01), G02F1/1368 (2006.01), H05B33/26 (2006.01)							
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社							
1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。							
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と含めて全部で 5 ペー	ジからなる。					
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. 🔽 附属書類は全部で 1 ページである。							
✓ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)							
□ 第1欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙							
 b. <u> </u> 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。					
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)							
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	· 合む。						
▼ 第Ⅰ欄 国際予備審査報告の基礎							
□ 第Ⅱ欄 優先権 □ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性	E又は産業上の利用可能性についての国際	予備審査報告の不作成					
第11個 利然性、進多は 第1V欄 発明の単一性の							
▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明							
厂 第VI欄 ある種の引用文	、献						
第VII欄 国際出願の不備							
☑ 第四欄 国際出願に対す	⁻ る意見						

国際予備審査の請求書を受理した日 06.06.2005	国際予備審査報告を作成した日 18.01.2006
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 伊藤 昌哉
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3274

第	I欄	欄 報告の基礎				
1.	言語	言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。				
		▽ 出願時の言語による国際出願				
	•		细歌文			
	,	国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))				
		「国際公開 (PCT規則12.4(a))				
		「国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))				
	- c					
۷.	この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)					
	Г	出願時の国際出願書類				
	V	区 明細書				
		第 $1-10$ ページ、出願時に提出されたもの				
		第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が	受理したもの			
		第 付けで国際予備審査機関が	受理したもの			
	V	▼ 請求の範囲				
		第 <u>3-9</u> 項、出願時に提出されたもの				
		第				
		第 項*、16.12.2005 付けで国際予備審査機関が 第 項*、 付けで国際予備審査機関が	受理したもの 受理したもの			
		·	ス なした 000			
	V	♥ 図面 第 1 = 4 図 図 出際時に思出されたもの				
		第 <u>1 年</u> 図 、	受理したもの			
		第 1 - 4 図 、出願時に提出されたもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が	受理したもの			
	Г					
	1:	配列表に関する補充欄を参照すること。				
3.	V	▼ 補正により、下記の書類が削除された。				
		- 明細書 第 ページ				
		「 明細書 第 ページ 請求の範囲 第 <u>2 項</u> 項				
		図面 第				
		: 配列表 (具体的に記載すること)				
		□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)				
4.			示の範囲を超			
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2	(c))			
		厂 明細書 第 ページ				
		「 請求の範囲 第 項				
		□ 配列表(具体的に記載すること)□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	— I			
	•	- The second of				
* 4	. に	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。				

第V欄 新規性、進歩性又は産業」 それを裏付ける文献及び	上の利用可能性についての法第 12 条(P C T 35 条(2))に定めるり 説明	見解、
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 1,3-9 請求の範囲	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 1,3-9	有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1, 3-9	有

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1: JP 2003-316292 A 文献2: JP 2003-101031 A 文献3: JP 2003-51386 A 文献4: JP 2003-115456 A 文献5: JP 10-321369 A

請求の範囲

請求の範囲1について

文献1、2には、基板上に、表示素子部と薄膜トランジスタ部が、この順番に、積層形成され、表示素子部の画素電極が薄膜トランジスタのドレイン電極を兼ねている構成を有する表示装置が開示されている。

この表示装置において、表示素子部と薄膜トランジスタ部の積層の順番を単に逆にして、基板上に、薄膜トランジスタ部と表示素子部が、この順番に、積層形成された構成とすることは、当業者には容易である。(文献1、2には、表示素子部と薄膜トランジスタ部の積層の順番を逆にすることを阻害する記載はない。)

また、文献1、2に記載された薄膜トランジスタでは、ソース電極は、画素電極に対して厚み方向に能動層を介して対抗して形成されている。

さらに、文献1、2には、画素電極とソース電極は面積が等しく、画素電極が能動層部を覆い尽くす構成が開示されている。これに対して、本願の発明では、画素電極は、ソース電極より大きい面積を有し、画素電極が能動層部を覆い尽くす構成であるが、画素電極の面積とソース電極の面積を比較して、画素電極の面積がソース電極の面積より大きい構成が格別な効果を奏するとは認められない。すなわち、出願人が主張する有機半導体層への酸素や水分の浸入を防止するという効果は、画素電極の面積が、それ単独で大きく、画素電極が能動層部を覆い尽くすことにより奏し得る効果であり、画素電極の面積がソース電極の面積より大きい構成が奏するものではない。

すると、文献1、2の画素電極とソース電極は面積が等しい構成と、本願の画素電極は、ソース電極より大きい面積を有する構成との差異は、単なる設計上の微差にすぎない。

なお、第 VIII 欄にも記載するように、本願の明細書では、画素電極は、ソース電極より大きい面積を有する構成により、画素電極を回り込んで能動層の側方から有機半導体層への酸素や水分の浸入を防止するという効果を奏するという技術思想は開示されていない。

第四欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲2の「前記画素電極は、前記ソース電極よりも大きい面積を有し」という 記載の明細書による裏付けについて

出願人は、答弁書にて、段落 [0023]、[0024]、図1B及び図3Bに記載されていると主張する。

しかし、段落 [0023]、[0024] には、ソース電極は画素電極の面積の25%以上の大きさとすることが記載されるのみである。そして、この記載では、ソース電極の面積は、画素電極の面積より小さい、等しい、大きいもののすべてが含まれる。また、ソース電極の面積は画素電極の面積より小さい、すなわち、画素電極の面積はソース電極の面積より大きい構成を特筆する記載はない。図1B、図3Bは、ソース電極は画素電極の面積の25%以上の大きさとすることの1実施例を開示するのみである。

さらに、本願の明細書では、画素電極は、ソース電極より大きい面積を有する構成により、画素電極を回り込んで能動層の側方から有機半導体層への酸素や水分の浸入を防止するという効果を奏するという技術思想は開示されていない。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V-2 欄の続き

したがって、請求の範囲1に係る発明は、文献1、2により進歩性が否定される。

請求の範囲3について

文献1、2には、ソース電極と画素電極は面積が等しい構成が開示されている。すなわち、ソース電極は、画素電極面積の25%以上の大きさを有すると認める。

したがって、請求の範囲3に係る発明は、文献1、2により進歩性が否定される。

請求の範囲4について

文献1、2に記載された、透明電極は、ガス及び水分のガス透過を抑制するものと認める。

したがって、請求の範囲4に係る発明は、文献1、2により進歩性が否定される。

請求の範囲5について

液晶あるいは有機ELを挟む2つの電極のうち、薄膜トランジスタに接続されない側の電極を、表示領域全面に設けることは、周知の手段である。

したがって、請求の範囲5に係る発明は、文献1、2により進歩性が否定される。

請求の範囲6について

文献 1、2 に記載された表示装置の基板は、酸素及び水分のガス透過を抑制するものである。

したがって、請求の範囲6に係る発明は、文献1、2により進歩性が否定される。

請求の範囲7について

可撓性の基板は、文献3-5に開示されるように、周知のものである。 したがって、請求の範囲7に係る発明は、文献1-5により進歩性が否定される。

請求の範囲8について

文献1、2の表示装置は、有機EL表示装置である。

したがって、請求の範囲8に係る発明は、文献1-5により進歩性が否定される。

請求の範囲9について

文献1、2に記載された薄膜トランジスタは、有機半導体膜を含むものである。 したがって、請求の範囲9に係る発明は、文献1-5により進歩性が否定される。